









	<h2 style="color: red;">NVB25P06T4G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NVB25P06T4G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 60V 27.5A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  NVB25P06T4G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5020 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NVB25P06T4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 27.5A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5020 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	120W (Tj)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	27.5A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	82 mOhm @ 25A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1680pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NVB25P06T4G ist neu im Original, Suche NVB25P06T4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NVB25P06T4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NVB25P06T4G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NVB60N06T4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V D2PAK</p>	 <p>NVB6410ANT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 76A D2PAK</p>	 <p>NVB5405NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 16.5A D2PAK</p>	 <p>NVB5860NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 169A D2PAK</p>
 <p>NVB5860NL VB NVB5860NL VB</p>	 <p>NVB5860N VB NVB5860N VB</p>	 <p>NVB5426NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK</p>	 <p>NVB6411ANT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 75A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

6DI100A-050P	A50L-0001-0340	AZ755-1A-24DE	BCX41QTA	BZX84C9V1
C2012X5R1V225M125AB	C5750X7R2A155K230KM	CP1117D50A	FDS6570-NL	FMBM5401
FQH17P06TU	GRM188R71H473KA61J	GRM31A7U3D180JW31D	GT-14080	HD6432639UA14FJNS
HGT1S7N60A4DS	IXTQ36N50P	K4X1G323PE-8GC6	LC78620E-D	LE79231DJC
LP3917RLN-NL	M38037M6-520HP	MSM5416258B-45T3-K	NLFV32T-3R3M-EF	NVB5426NT4G
NVB5860N	NVB5860NL	NVB5860NT4G	NVB60N06T4G	NVB6410ANT4G
NVB6411ANT4G	NVB6412ANT4G	NVB6413ANT4G	NVBF170LT1G	P4SMA7.5CA
PM8903TR-6	RJK1557DPA-00-J0	SC84554CM	SG2526DW	SKD110-16
TA629667	TDA7050/N3/S6	TLV2622IDGK	TPS2551QDBVR	TPS61006DGSRG4
VND5E050AK	W25Q80BLPT26	WPH95-18	XC2C64A-7PG56I	XC9223B082DRN

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited